

D35-115C 下線晶片資料

請注意：

- 1.此資料包含:下線晶片。
- 2.下線晶片資料按 前瞻部分負擔、優良晶片、合作計劃晶片、前瞻速審部分負擔、教育性晶片排列。
- 3.申請編號中，序號英文字母代表：A:前瞻部分負擔，E:教育性晶片，N:新進教師晶片，I:優良晶片，P:合作計劃晶片，R:前瞻速審部分負擔晶片。序號之尾端字母代表：a:使用 Cell-based Design Kit，m:使用 Multi-option-MEMS(TSRI MEMS 後製程)。
- 4.可否下線準則依序: 有無回覆委員建議(未回覆完整視同未回覆,不予下線)、審查評等結果(優先順序為 A>B>C，D:視面積使用情況下線，F:不予下線)、教授加總積點、可擺放的剩餘面積等。
- 5.若委員建議修改佈局，依規定不可比原佈局增加長寬邊的長度，違者則不予採用已修改之佈局檔案。

下線晶片資料(申請編號/專題名稱(課程名稱)/包裝形式/晶片面積)：

申請編號: D35-115C-A0001

專題名稱(中文): 應用於心臟相關生物標記感測之 CMOS 電容式感測陣列

專題名稱(英文): CMOS Capacitive Sensing Array for Cardiac-related Biomarkers Detection

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 2.820*2.500 mm²

申請編號: D35-115C-A0002

專題名稱(中文): 用於檢測心肌生物標記之阻抗式 2x2 感測陣列

專題名稱(英文): Impedimetric 2x2 Sensing Array for the Detection of Cardiac Biomarkers

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 2.600*2.600 mm²

申請編號: D35-115C-A0003

專題名稱(中文): CMOS 非冷卻式紅外線感測陣列之開發

專題名稱(英文): Development of uncooled CMOS infrared sensors

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 3.160*3.140 mm²

申請編號: D35-115C-A0006a

專題名稱(中文): 應用於電化學阻抗頻譜量測系統之信號處理晶片

專題名稱(英文): Design of a Signal Processing IC for Electrochemical Impedance Spectroscopy Measurement System

包裝形式: Package:48 S/B:8Pcs + DieSort:10EA

晶片面積: 2.184*1.936 mm²

申請編號: D35-115C-A0008

專題名稱(中文): 適用於環境監測之二氧化碳感測晶片

專題名稱(英文): Carbon Dioxide Micro Sensor Chip for Environmental Monitoring

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.880*1.495 mm²

申請編號: D35-115C-A0010

專題名稱(中文): 基於氧化銦錫延伸閘極電晶體之胰臟癌外泌體蛋白質感測研究

專題名稱(英文): Research on an Indium Tin Oxide Extended-Gate Transistor-Based Sensing for the Detection of Exosomal Protein in Pancreatic Cancer

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 2.820*2.820 mm²

申請編號: D35-115C-A0011

專題名稱(中文): 多間距電容式近接感測器的取樣電路

專題名稱(英文): Sampling circuit for multi-gap capacitive proximity sensors

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.900*1.800 mm²

申請編號: D35-115C-A0012

專題名稱(中文): 結合 PCB 指交型電極與 CMOS 讀取電路於肝癌生物標記感測之研究

專題名稱(英文): Research on Integrating PCB Interdigitated Electrodes with CMOS Readout Circuits for Liver Cancer Biomarker Sensing

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 3.000*1.960 mm²

申請編號: D35-115C-A0013

專題名稱(中文): 基於軟性基板電容式感測與 CMOS 讀取電路之 PSA 前列腺癌生物感測器開發

專題名稱(英文): Development of a PSA Biosensor for Prostate Cancer Based on Flexible-Substrate Capacitive Sensing and CMOS Readout Circuit

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 2.500*2.680 mm²

申請編號: D35-115C-A0014

專題名稱(中文): 整合微流道抓取之 ITO-CMOS 連續式電容感測與心跳訊號解調系統
專題名稱(英文): Microfluidics-Integrated ITO-CMOS Continuous Capacitive Sensing and Heartbeat Signal Demodulation System
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 2.404*1.720 mm²

申請編號: D35-115C-A0015m
專題名稱(中文): 長熱電偶堆疊式微型熱電發電器
專題名稱(英文): Long Thermocouple Stacked Micro Thermoelectric Generator
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 1.920*1.850 mm²

申請編號: D35-115C-I0001
專題名稱(中文): 具多通道配置之行列式選址 2-D 電容式超聲波換能器成像陣列
專題名稱(英文): A Row-Column Addressed 2-D CMUT Imaging Array with Multiple Channel Configurations
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 5.680*5.680 mm²

申請編號: D35-115C-P0001
專題名稱(中文): 基於 CMOS-MEMS 之多模態感測中樞：單晶整合壓阻式與電容式三軸力、電阻式溫度及熱感測功能
專題名稱(英文): CMOS-MEMS-Based Multimodal Sensing Hub with Monolithic Integration of Piezoresistive and Capacitive Tri-Axial Force, Resistive Temperature, and Thermal Sensing
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 2.940*2.940 mm²

申請編號: D35-115C-P0002
專題名稱(中文): 應用於氣象監測之 CMOS-MEMS 整合風速、風向、壓力與溫度感測器設計
專題名稱(英文): Design of a CMOS-MEMS Integrated Wind Speed, Wind Direction, Pressure, and Temperature Sensor for Meteorological Monitoring
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 2.800*2.800 mm²

申請編號: D35-115C-P0003
專題名稱(中文): 採用可變形線圈且具電流可調靈敏度與電容式近接感測之霍爾效應觸覺感測器
專題名稱(英文): A Hall-Effect Tactile Sensor Using a Deformable Coil with Current-Tunable Sensitivity and Capacitive Proximity Sensing
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 2.980*2.600 mm²

申請編號: D35-115C-P0004

專題名稱(中文): 具雙層並聯指叉式電極之空氣介質 CMOS 電容式濕度感測器設計

專題名稱(英文): Design and Characterization of a Dual-Layer Parallel Interdigitated Electrodes (IDE) Air-Type CMOS Humidity Sensor

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 4.000*2.000 mm²

申請編號: D35-115C-P0005

專題名稱(中文): 熱導與紫外光活化雙機制氣體感測器暨紫外光 LED 晶粒整合元件

專題名稱(英文): Dual-Mechanism Gas Sensor Based on Thermal Conductivity and UV Activation with Integrated UV LED Die

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 2.740*2.740 mm²

申請編號: D35-115C-P0006

專題名稱(中文): 基於非接觸式萃取 CMOS 多晶矽壓阻特性之鋰離子軟包電池即時健康狀態監測系統開發

專題名稱(英文): Development of Real-time SOH Monitoring System for Li-ion Pouch Cells Based on Non-contact Extracted Piezoresistive Coefficients of CMOS Polysilicon

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 2.800*2.800 mm²

申請編號: D35-115C-P0007

專題名稱(中文): 週期性腔體結構與超穎吸收體整合於熱電式紅外線感測器之吸收增強研究

專題名稱(英文): Absorption Enhancement of Thermoelectric Infrared Sensors Using Integrated Periodic Cavity and Metamaterial Absorber Structures

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 3.060*2.600 mm²

申請編號: D35-115C-P0008

專題名稱(中文): 透過熱結構陣列優化氣體選擇比與穩定性監測之 CMOS 氣體感測器研究

專題名稱(英文): CMOS Gas Sensors Based on Thermal-Structure Arrays for Enhanced Gas Selectivity and Stability Monitoring

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 4.300*2.500 mm²

申請編號: D35-115C-P0009

專題名稱(中文): 熱成像與動作偵測而設計之低成本長波紅外線熱電堆感測器

專題名稱(英文): Low cost long wave infrared thermopile sensor designed for thermal imaging and motion detection

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 3.440*2.000 mm²

申請編號: D35-115C-P0010

專題名稱(中文): 垂直整合電感式觸覺感測器與霍爾式加速度計

專題名稱(英文): Vertically Integrated Inductive Tactile Sensors and Hall-Effect Accelerometers

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 4.000*2.000 mm²

申請編號: D35-115C-P0011

專題名稱(中文): 利用巢狀矩形框架實現應變模式解耦之三軸 CMOS-MEMS 壓阻式觸覺感測器

專題名稱(英文): Tri-Axial CMOS-MEMS Piezoresistive Tactile Sensor Using a Nested Rectangular Frame for Strain-Mode Decoupling

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 2.920*2.880 mm²

申請編號: D35-115C-R0001

專題名稱(中文): 結合 ITO 電極與 CMOS 讀取電路於心臟類器官生醫感測之研究

專題名稱(英文): Research on Integrating ITO Electrodes with CMOS Readout Circuits for Biomedical Sensing in Cardiac Organoids

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 2.400*1.920 mm²

申請編號: D35-115C-R0002

專題名稱(中文): 用於粉末冶金生胚之超聲波換能器的設計與驗證

專題名稱(英文): Design and Verification of Ultrasonic Transducers for Powder Metallurgy Green Compacts

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.748*1.748 mm²

申請編號: D35-115C-R0003

專題名稱(中文): 超穎吸收體結構於熱電式紅外線感測陣列之整合設計與研究

專題名稱(英文): Integrated Design of Metamaterial Absorber Structures for Thermoelectric Infrared Sensor Arrays

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 3.400*2.300 mm²

申請編號: D35-115C-R0004

專題名稱(中文): 以超穎表面吸收層應用於多方向感測之熱電式紅外線感測器

專題名稱(英文): Thermoelectric Infrared Sensor with a Metasurface Absorber for Multi-Directional Sensing

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 3.960*1.980 mm²

申請編號: D35-115C-E0002m

專題名稱(中文): 紅外線感測器專論

專題名稱(英文): 橋式電路整合於晶片上之 派藍尼真空計製程變異透過偏壓調整零點復歸研究(Study on Zero-Point Restoration by Bias Adjustment for Process Variations in a Pirani Vacuum Gauge with an On-Chip Integrated Bridge Circuit)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.400*1.400 mm²

申請編號: D35-115C-E0003

專題名稱(中文): 量子積體電路概論

專題名稱(英文): 具快速暫態響應之高效率 PWM 降壓型轉換器電路晶片設計(Circuit and IC Design of a High-Efficiency PWM Buck Converter with Fast Transient Response)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.300*1.300 mm²

申請編號: D35-115C-E0004

專題名稱(中文): 專題研究

專題名稱(英文): 直流與交流操作下雙閘極離子場效電晶體之特性分析(Characteristic Analysis of Dual-Gate Ion-Sensitive Field-Effect Transistors under DC and AC Operations)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.482*1.480 mm²

申請編號: D35-115C-E0005m

專題名稱(中文): 論文

專題名稱(英文): 以適體巨分子驅動之新型 CMOS MEMS 薄膜式奈米力學感測器設計與開發(Design and Development of a Novel CMOS-MEMS Thin-Film Nanomechanical Sensor Driven by Aptamer Macromolecules)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.490*1.490 mm²

申請編號: D35-115C-E0006m

專題名稱(中文): 論文

專題名稱(英文): 以適體巨分子驅動之新型 CMOS MEMS 薄膜式奈米力學感測器設計與開發(Design and Development of a Novel CMOS-MEMS Thin-Film Nanomechanical Sensor Driven by Aptamer Macromolecules)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.490*1.490 mm²

申請編號: D35-115C-E0007m

專題名稱(中文): 論文

專題名稱(英文): 以適體巨分子驅動之新型 CMOS MEMS 薄膜式奈米力學感測器設計與開發
(Design and Development of a Novel CMOS-MEMS Thin-Film Nanomechanical Sensor Driven by Aptamer Macromolecules)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.480*1.490 mm²

申請編號: D35-115C-E0008

專題名稱(中文): 量子積體電路概論

專題名稱(英文): 應用於智慧型電源管理之脈波寬度調變積體電路設計(Design of a Pulse-Width Modulation Integrated Circuit for Intelligent Power Management)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.300*1.300 mm²

申請編號: D35-115C-E0009m

專題名稱(中文): 電機實務專題(一)

專題名稱(英文): 場發射三極體結合轉阻放大器之設計(Design of a Field-Emission Triode Integrated with a Transimpedance Amplifier)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.474*1.469 mm²

申請編號: D35-115C-E0011m

專題名稱(中文): 電機實務專題(一)

專題名稱(英文): 平面式場發射三極體整合反相器電路設計(Circuit Design of Planar Field Emission Triode Integrated with Inverter)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.494*1.472 mm²

申請編號: D35-115C-E0012

專題名稱(中文): 類比積體電路設計導論

專題名稱(英文): 脈波頻率調變待機模式控制升壓轉換器(PFM Boost Converter with Standby Mode Controller)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.202*1.259 mm²

申請編號: D35-115C-E0013m

專題名稱(中文): 紅外線感測器專論

專題名稱(英文): 不同中央電阻占比之 CMOS-MEMS 微加熱器設計與熱特性分析(Design and Thermal Characterization of CMOS-MEMS Microheaters with Different Central Resistance Ratios)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.400*1.400 mm^2

=====